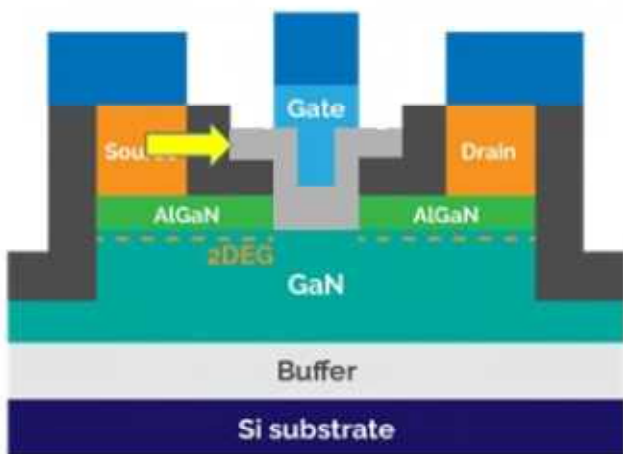




RF GaN/ GaN パワーデバイス

5Gネットワーク、省エネ、再生可能エネルギー分野に高周波、高効率の次世代デバイスとして採用

RF GaN/GaN パワーデバイスのゲート絶縁膜



量産用世界最速プラズマALD装置 Atomfab®

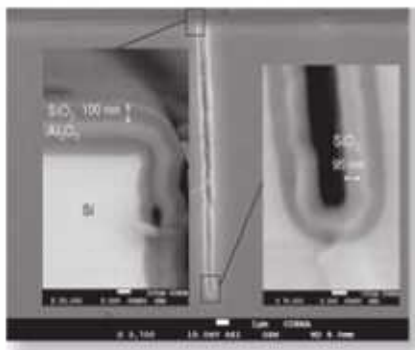
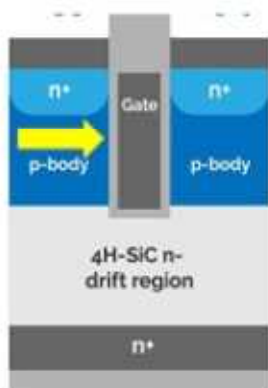


SiC パワーデバイス

電気自動車、ハイブリッドに、より小型・省電力・高温下で高性能を実現

SiCパワーデバイスへのALD採用例：ゲート絶縁膜 (SiO₂)

ALDでは高い品質のSiO₂膜を、アスペクト比の高い構造にコンフォーマルに成膜が可能です。



高品質SiO ₂ PEALD プロセスデータ	
ブレイクダウン電圧 (MV/cm)	>10MV/cm at 200 °C成膜
サイクルタイム (PEALD)	1.3 nm/ min
膜厚分布 (200mm, 3mm EE)	< ±1.6%
アスペクト比	AR >30:1 (300°C基板加熱下)